

تصميم H barge قادر على تحمل أكثر من 3 أمبير

مكونات الدائرة وتحديد نوع الترانسيستور :

1. IRF630 : N-Channel Power MOSFETs, 12A, 150-200 V
2. 2N6845 : POWER MOSFET P-CHANNEL(BV_{dss}=-100V, R_{ds(on)}=0.60ohm, I_d=-4.0A)
3. 4N25-6 : Pin DIP Optoisolators Transistor Output
4. Battery
5. FUSE
6. IRF630
7. Resistor
8. LOGICTOGGLE

